

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 3 月 10 日 (2016.3.10)

【公開番号】特開 2015-82592 (P2015-82592A)

【公開日】平成 27 年 4 月 27 日 (2015.4.27)

【年通号数】公開・登録公報 2015-028

【出願番号】特願 2013-220141 (P2013-220141)

【国際特許分類】

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

H 0 1 L 27/14 (2006.01)

H 0 1 L 29/423 (2006.01)

H 0 1 L 29/49 (2006.01)

H 0 4 N 5/369 (2011.01)

H 0 4 N 5/374 (2011.01)

【 F I 】

H 0 1 L 27/14 A

H 0 1 L 27/14 D

H 0 1 L 29/58 G

H 0 4 N 5/335 6 9 0

H 0 4 N 5/335 7 4 0

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 1 月 26 日 (2016.1.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 6 】

【図 1】本技術を適用した固体撮像素子の概略構成例を示すブロック図である。

【図 2】図 1 の画素の等価回路を示す図である。

【図 3】画素の第 1 の実施の形態の画素構造を示す断面図である。

【図 4】隣接する 4 つの画素の平面図である

【図 5】第 1 転送トランジスタの転送チャネルを説明する図である。

【図 6】フォトダイオードとメモリ部の基板深さ方向のポテンシャルを示す図である。

【図 7】画素の製造方法について説明する図である。

【図 8】画素の製造方法について説明する図である。

【図 9】画素の製造方法について説明する図である。

【図 10】画素の製造方法について説明する図である。

【図 11】画素の製造方法について説明する図である。

【図 12】画素の製造方法について説明する図である。

【図 13】画素の製造方法について説明する図である。

【図 14】画素の第 2 の実施の形態の画素構造を示す断面図である。

【図 15】画素の第 3 の実施の形態の画素構造を示す断面図である。

【図 16】画素の第 4 の実施の形態の画素構造を示す断面図である。

【図 17】本技術を適用した電子機器としての撮像装置の構成例を示すブロック図である。